

CVD-SiC -高純度バルクSiC-

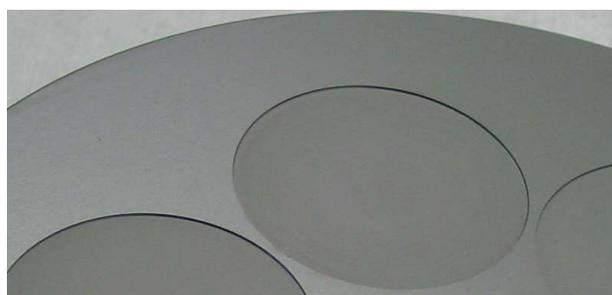
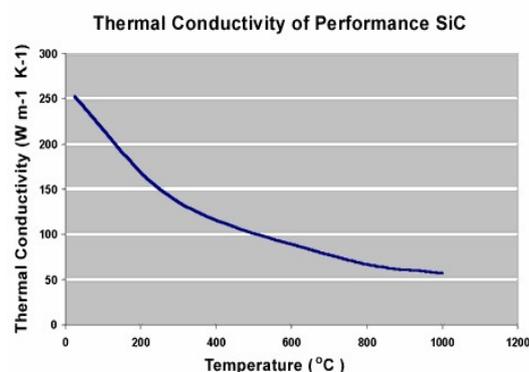
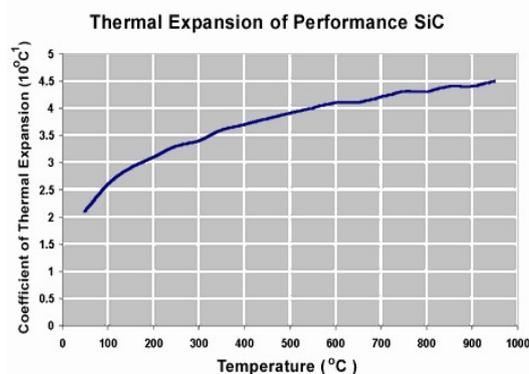
CVD-SiCは独自の気相成長法(CVD法)によって製造された高純度バルクSiCです。SiCコーティング品におけるピンホールや剥離の問題が起こること無く、また電気抵抗値の調整が可能で、HR Grade (高抵抗)、ELR(低抵抗) 2種類の供給が可能です。半導体向けに幅広く利用されております。

特徴

- ・高純度99.9995%
- ・高熱伝導率
- ・耐プラズマ性
- ・高耐熱性
- ・ダスト低減のための表面処理可能
- ・放電加工可能
- ・酸素、アンモニア雰囲気でも使用可能



密度	g/cm ³		3.21
硬度(ピッカース)	-		2800
曲げ強度	MPa	RT	370
		1300°C	560
破壊靱性	MPa·m ^{1/2}		2.94
熱伝導率	W/m·K	HR grade	250
		ELR grade	220
熱膨張率	-		4.5
電気伝導率	Ω·cm	HR grade	> 1
		ELR grade	< 0.1
比熱	J/g·K		0.66



Fe	Ni	Cu	Al	Ca	Na	Cr	K	Ti	V	B	Mn	Zn	W
<0.05	0.13	<0.05	<0.01	<0.05	<0.01	<0.1	<0.05	<0.005	<0.005	<1.4	<0.01	<0.05	<0.01

Properties determined by glow discharge mass spectroscopy. (Unit : ppm)